

博士課程教育リーディングプログラム
2019 年度 バトンゾーン特論講演会

豊橋技術科学大学 2019 年度第 3 回特別講演

フラッシュメモリの発明に繋がった大切な出会い

(株) ホンダリサーチ・インスティテュート・ジャパン
プリンシパル・サイエンティスト

さく い こう じ
作 井 康 司 氏



1979 慶應義塾大学工学部計測工学専攻卒業
1981 同大学院修士課程修了
1981 東京芝浦電気（現東芝）に入社
総合研究所 IC 研究所に勤務 DRAM 回路設計を経て高密度 NAND 型のフラッシュメモリの研究開発に従事
1991-1993 スタンフォード大学電気工学科 客員研究員
1995 工学博士（東北大学）
2002. 4 東芝 SoC 研究開発センター フラッシュメモリ設計開発部長
2004. 12 SONY 半導体事業グループ メモリシステム部 統括部長
2007. 4 インテル NAND 事業部リサーチサイエンティスト
2010. 6 マイクロンジャパン シニアアーキテクト&テクノロジスト・メモリーノベーションズ
2012 IEEE Fellow 受賞「NAND フラッシュメモリへの貢献」
2017. 12 (株)ホンダ・リサーチ・インスティテュート・ジャパン プリンシパル・サイエンティスト 2035 年を視野に入れた AI 研究に従事、現在に至る。

概要

東芝を代表とする日本がフラッシュメモリの技術革新を牽引した結果、iPhone 等のスマートフォン、USB、SD カード、SSD と広く応用されています。全世界で生産されるフラッシュメモリは、2017 年には 6 兆円のビジネスに到達し、Google 等のサーバーに搭載され、そのための研究開発も活発に進められています。本講演では、(1) 東芝の舩岡富士雄博士が発明したフラッシュ、NOR 型フラッシュメモリ、NAND 型フラッシュメモリがいかに生み出されたか、(2) 研究技術者を育てることが研究開発に必要であり、0 から 1 を起こすための研究開発には、特許、論文、製品が大切であることを、お話しいただく予定です。

日時：令和元年 **10 月 24 日（木）**
14:40~16:10

会場：豊橋技術科学大学 A2-101 講義室

問い合わせ先：豊橋技術科学大学リーディング大学院教育推進機構
leading@office.tut.ac.jp 電話 0532-44-1028

後援：豊橋商工会議所、社会人キャリアアップ連携協議会